

※課題番号 : F-12-KT-0140  
※支援課題名 (日本語) : 貫通穴形状を持った MEMS 構造物の製造方法と、高段差ウエハのダイシング方法開発  
※Program Title (in English) : Development of Fabrication Process for MEMS Structure with Through Holes and Dicing Technique for High Bumped Wafer.  
※利用者名 (日本語) : 野田 隆一郎  
※Username (in English) : Ryuuichirou Noda  
※所属名 (日本語) : 横河電機株式会社 半導体センターシリコン開発 2 部  
※Affiliation (in English) : Yokogawa Electric Corporation

※概要 (Summary) :

【相談内容】

シリコン基板に対して、貫通穴を含んだ所望の形状を得られるような加工方法を開発したい。また、作製した構造物をダイシングするときに、高段差を持ったウエハを正常にダイシングすることのできる方法を確立したい。

○希望利用装置 :

- ・ダイシングソー (B19)
- ・紫外線照射装置 (B21)

【回答】

高段差をもったシリコン基板のダイシングは若干難易度の高いものである。しかし、状況を確認しながら進めることで、装置管理的にも対応可能であると推測される。

【結果】

H25 年度 5 月にテストプロセスとして装置利用を開始する。(ナノテクノロジープラットフォーム事業利用予定)

※実験 (Experimental) :

技術相談のため割愛。

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談のため割愛。

※その他・特記事項 (Others) :

特になし。